


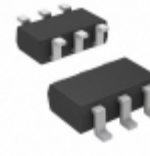




	<h2>SI3552DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3552DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3552DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 90093 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3552DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	90093 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 1.15W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.15W
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI3552
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3552DV-T1-GE3TR


SI3552DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3552DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3552DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3552DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3585CDV VISHAY SI3585CDV VISHAY</p>	 <p>SI3529DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3552DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP</p>	 <p>SI3585CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 3.9A 6TSOP</p>
 <p>SI3554DV-T1-E3 Vishay Precision Group SI3554DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI3552DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 6TSOP</p>	 <p>SI3552DV-T1 VISHAY SI3552DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3552DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DV	 SI3493DV-T1	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3
 SI3493DV-T1-E3.	 SI3493DV-T1-GE3	 SI3493DV-T1-GE3	 SI3495DV	 SI3495DV-T1-E3
 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-E3
 SI3499DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3500-A-GM	 SI3529DV-T1-GE3	 SI3529DV-T1-GE3
 SI3552DV	 SI3552DV-T1	 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-GE3
 SI3585CDV	 SI3585CDV-T1-GE3	 SI3585CDV-T1-GE3	 SI3585DV	 SI3585DV-T1
 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-GE3	 SI3585DV-T1-GE3	 SI3586DS-TI-E3
 SI3586DV	 SI3586DV-T1-E3	 SI3586DV-T1-E3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3586DV-T1-GE3
 SI3588DV	 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-GE3	 SI3588DV-T1-GE3
 SI3590DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3801DV-T1	 SI3803DV-T1	 SI3805DV-T1

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited